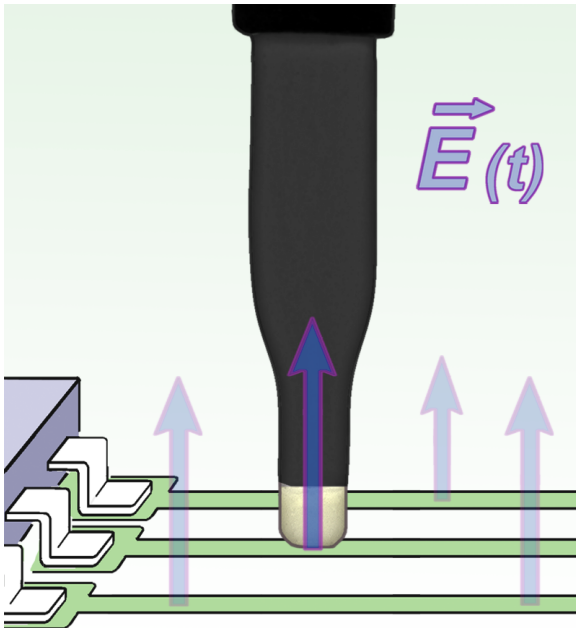


# RFS-E 10

Scannersonde 30 MHz bis 3 GHz



## Kurzbeschreibung

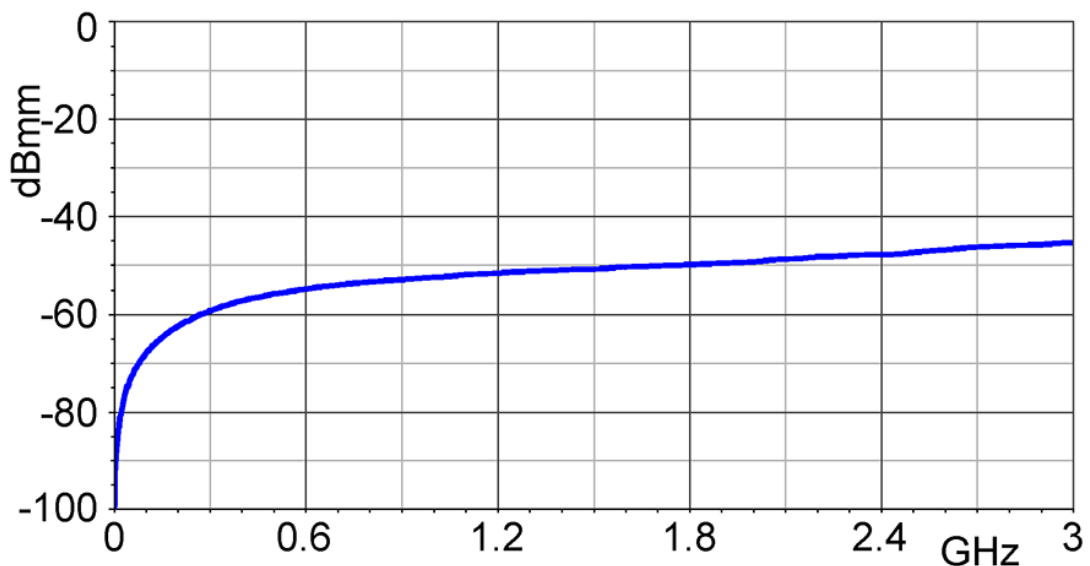
Die Elektrode in der Unterseite des Sondenkopfes der E-Feld Scannersonde RFS-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs.

Die RFS-E 10 ist eine passive E-Feld Scannersonde. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Die RFS-E 10 hat eine Mantelstromdämpfung und die Oberseite des Sondenkopfes ist elektrisch geschirmt. Die E-Feldscannersonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50  $\Omega$  Abschlusswiderstand.

## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	$\approx 0.2$ mm
Maße Sondenkopf	$\approx (0.5 \times 2)$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

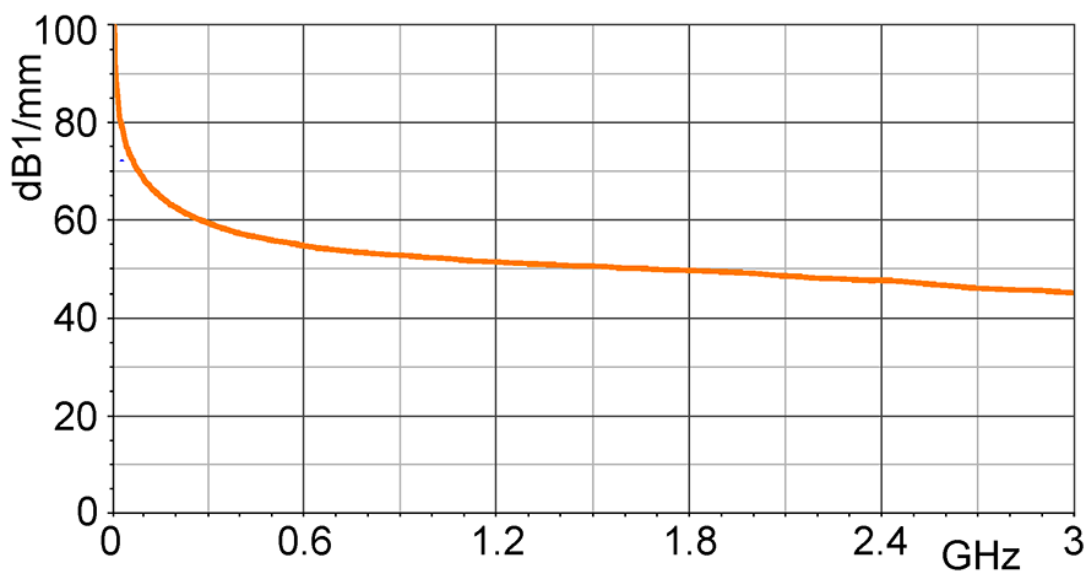
Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ A/m]



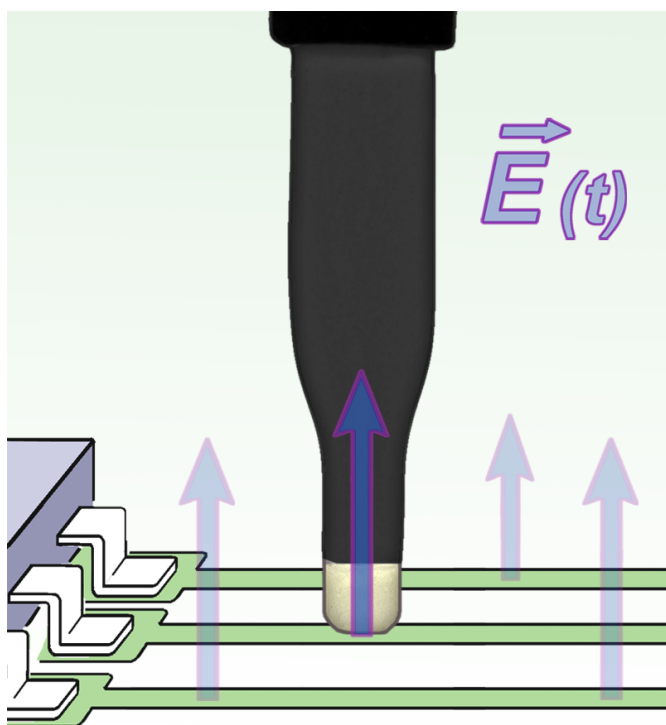
# RFS-E 10

Scannerprobe 30 MHz bis 3 GHz

Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



# RFS-E 10

Scannersonde 30 MHz bis 3 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

